

SONY[®]
SEMICONDUCTORS

2SD1068

T E N T A T I V E

17-2T-1405

2SD1068は、ガードリング、SIPOS膜等の技術を用いて作られた高電圧増幅、スイッチング用のTr.で複写機、ファクシミリ等の制御回路。ドライブ回路に最適です。

- 1. 特長
 - ・高耐圧 $V_{CBO} 1kV$
 - ・小電流の h_{FE} が高い。 $h_{FE} \geq 30$ at $I_C = 100\mu A$
 - ・2SB832とコンプリメンタリ動作ができる
- 2. 構造 Si NPN SIPOS Tr.
- 3. 用途 電圧増幅
- 4. 外形 TO-220

5. 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1000V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	900V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	10V
コレクタ電流(パルス)	I_{CP}	1A
コレクタ電流	I_C	10mA
ベース電流	I_B	5mA
コレクタ損失	$P_C(T_a = 25^\circ C)$	1.1W
	$P_C(T_c = 25^\circ C)$	25W
接合部温度	T_j	120 $^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-50~+150 $^\circ C$

6. 電気的特性 (Ta=25 °C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=0.1\text{mA}$	1000			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=2\text{mA}$	900			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=0.1\text{mA}$	10			V
コレクタ遮断電流	I_{CES}	$V_{CE}=1000\text{V}, R_{EB}=0$			10	μA
"	I_{CER}	$V_{CE}=900\text{V}, R_{EB}=50\text{k}\Omega$			30	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=10\text{V}, I_C=0$			2	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	50			
"	h_{FE2}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$	30			
コレクタ接合容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$		4.5	6	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=1\text{mA}$	5	8.5		MHz
スイッチング時間	t_d	Fig.1. $V_{CC}=500\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$		3.2		μs
	t_r			14.0		μs
	t_{stg}			32.0		μs
	t_r			14.0		μs

7. マーク表示

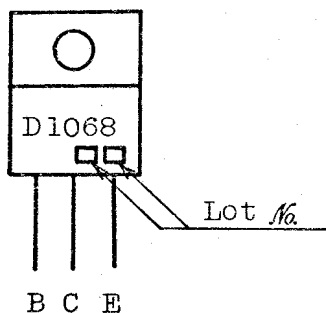
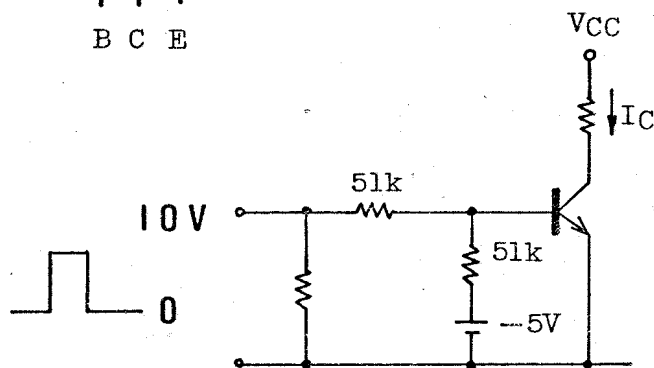
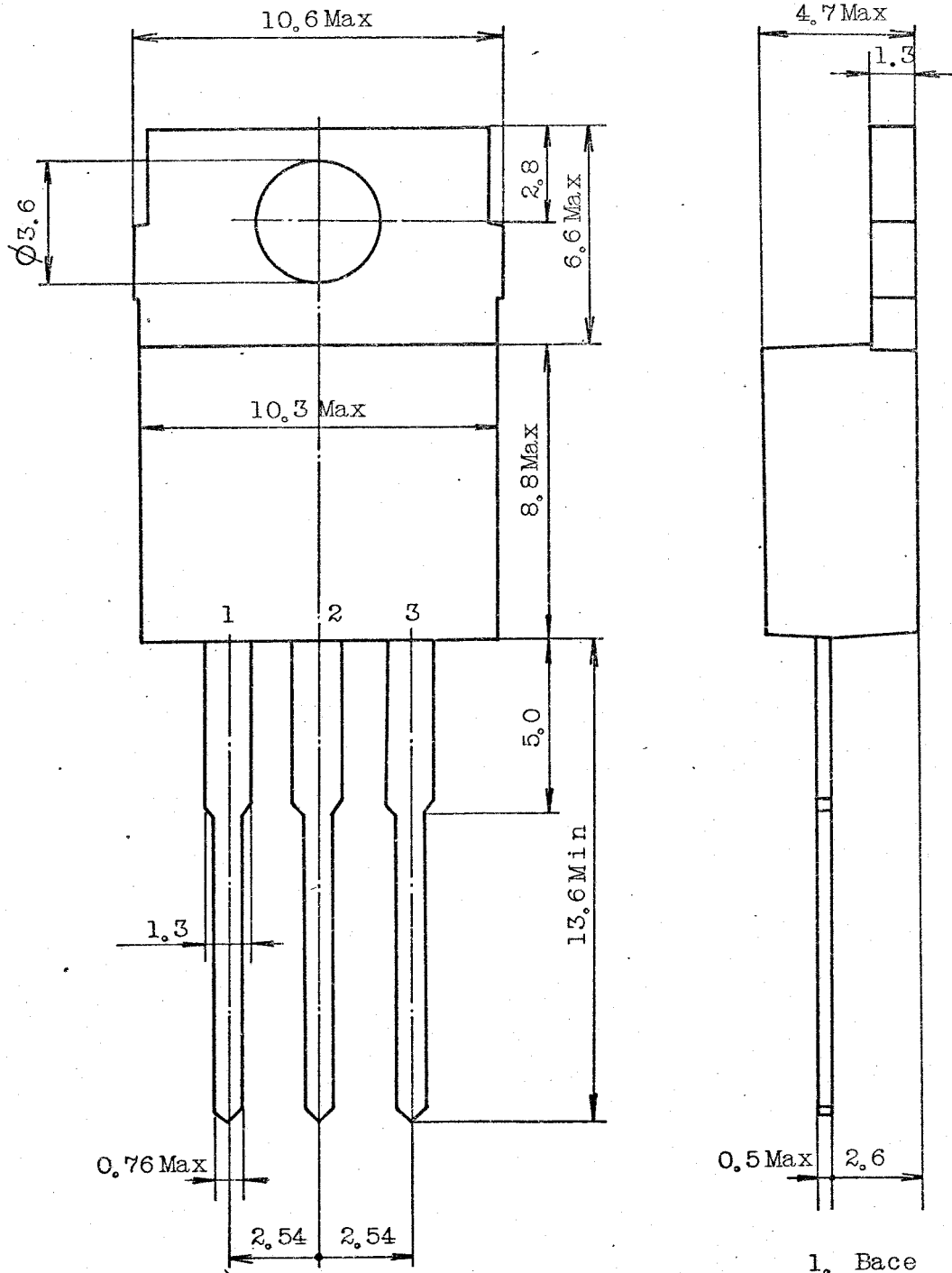


Fig.1



外形图



- 1. Base
- 2. Collector
- 3. Emitter

Unit: mm